



TITLE:

第1日(午前の部)

AUTHOR(S):

---

CITATION:

第1日(午前の部). 物性研究 1973, 21(1): F3-F3

ISSUE DATE:

1973-10-20

URL:

<http://hdl.handle.net/2433/88686>

RIGHT:

第 1 日（ 午前 の 部 ）

はじめに Introductory talk として、この研究会で予定されているいくつかの報告の位置づけと表面反転層の電子状態のレビューをかねて、植村泰忠氏「MOS 反転層入門」（原稿未着）の話があった。次に川路紳治氏「サーフオンとシリコン反転層の電子移動度」の報告があり、MOS 反転層における電子移動度をサーフオンによる散乱機構によって理解しようとする試みが紹介された。又この話題とは別に川路氏より p 型 InAs の低温における電気伝導の実験についてコメントがあり、超伝導の可能性が示されたことは興味深い。（佐久間哲郎）